

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局(43) 国際公開日
2005年10月6日 (06.10.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/093124 A1(51) 国際特許分類:
19/07, H01F 10/16, 41/18

C23C 14/34, C22C

(74) 代理人: 小越勇 (OGOSHI, Isamu); 〒1050002 東京都港区愛宕一丁目2番2号 虎ノ門9森ビル3階 小越国際特許事務所 Tokyo (JP).

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2005/002221

(22) 国際出願日:

2005年2月15日 (15.02.2005)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:
特願2004-092645 2004年3月26日 (26.03.2004) JP

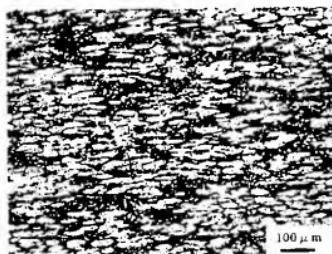
(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 株式会社日鉱マテリアルズ (NIKKO MATERIALS CO., LTD.); [JP/JP]; 〒1050001 東京都港区虎ノ門二丁目10番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中村 祐一郎 (NAKAMURA, Yuichiro) [JP/JP]; 〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4 株式会社日鉱マテリアルズ 磁工場内 Ibaraki (JP). 久野 見 (HISANO, Akira) [JP/JP]; 〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4 株式会社日鉱マテリアルズ 磁工場内 Ibaraki (JP).

(54) Title: Co-Cr-Pt-B BASED ALLOY SPUTTERING TARGET

(54) 発明の名称: Co-Cr-Pt-B系合金スパッタリングターゲット



100 μm

総圧延率: 約30%

ROLLING REDUCTION: APPROXIMATELY 30%

WO 2005/093124 A1

るCo-Cr-Pt-B系合金スパッタリングターゲットに関するとともに、パーティクルの発生を防止又は抑制し、成膜の品質を上げることを目的とする。

(57) Abstract: A Co-Cr-Pt-B based alloy sputtering target, characterized in that it has a rolled structure of an island form comprising a Co-rich phase being based on a primary crystal in casting, and the Co-Cr-Pt-B based alloy sputtering target wherein the rolled structure of an island form has an average size of 200 μm or less. The Co-Cr-Pt-B based alloy sputtering target can be reduced in the segregation and the residual stress caused in the casting and can have a uniform and fine rolled structure, which results in the prevention or inhibition of the generation of particles and in the improvement in the product yield in film forming. Further, said target can be produced with stability at a low cost.

(57) 要旨: 鋳造時の初晶をベースとしたCoリッチ相からなる島状の圧延組織を備えていることを特徴とするCo-Cr-Pt-B系合金スパッタリングターゲット。島状の圧延組織が平均寸法200 μm以下である同Co-Cr-Pt-B系合金スパッタリングターゲット。鋳造時の偏析や残留応力の少ない、均一微細な圧延組織を有するようにするとともに、パーティクルの発生を防止又は抑制し、成膜の品質を上げることを目的とする。